

用途：用于音频功率放大。

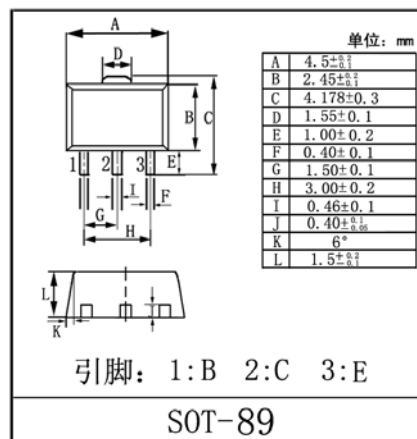
Purpose: Audio frequency power amplifier applications.

特点：饱和压降低，极好的 hFE 线性，与 2SD999 (3DG999) 互补。

Features: Low $V_{CE(sat)}$, excellent hFE linearity, complements the 2SD999 (3DG999).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-30	V
V_{CE0}	-25	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-1.0	A
I_{CP}	-1.5	A
P_C	500	mW
P_{C^*}	2.0	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



*:mounted on ceramic substrate ($16\text{mm}^2 \times 0.7\text{mm}$)

*装于 $16\text{mm}^2 \times 0.7\text{mm}$ 的陶瓷上。

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
I_{CB0}	$V_{CB}=-30\text{V}$	$I_E=0$			-0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-5.0\text{V}$	$I_C=0$			-0.1	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-1.0\text{V}$	$I_C=-100\text{mA}$	90	200	400	
$H_{FE(2)}$	$V_{CE}=-1.0\text{V}$	$I_C=-1.0\text{A}$	50	100		
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-1.0\text{A}$	$I_B=-100\text{mA}$		-0.25	-0.4	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=-1.0\text{A}$	$I_B=-100\text{mA}$		-1.0	-1.2	V
V_{BE}	$V_{CE}=-6.0\text{V}$	$I_C=-10\text{mA}$	-600	-640	-700	mV
f_T	$V_{CE}=-6.0\text{V}$	$I_C=-10\text{mA}$		110		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-6.0\text{V}$	$I_E=0$	$f=1.0\text{MHz}$	36		pF

$h_{FE(1)}$ 分档、印章标记/ $h_{FE(1)}$ Classifications、Marking:

$h_{FE(1)}$ 分档/ $h_{FE(1)}$ Classifications	M	L	K
$h_{FE(1)}$ 范围/ $h_{FE(1)}$ Range	90~180	135~270	200~400
印章/Marking	HDM*	HDL*	HDK*



2SB798 (3CG798)

